

令和 8 年度大学院博士前期課程一般入試における出題ミスについて

令和 7 年 9 月 4 日
室蘭工業大学

令和 7 年 8 月 27 日（水）に実施した令和 8 年度大学院博士前期課程一般入試における学力試験の試験問題の一部に誤りがあることが判明いたしました。

受験者の皆様には多大なご迷惑をおかけしたことを深く反省し、ここに報告いたします。

1. 出題ミスの内容

試験科目「応用物理学」の選択問題「物理系実験」の〔4〕（1）に示したグラフにおいて、横軸の目盛り（150、175、・・・、300、325、350）のうち、最も右端の数値が本来「350」であるところ、誤って「300」と表記されていた。（別紙参照）

2. 受験者への周知等

上記の誤りが解答に影響のないものであり、受験者全員が正答していたため、点数調整等の対応は行わない。

3. 今後の対応策

今後は、速やかに原因の究明と出題ミス再発防止に努め、入学試験の実施に万全を期したいと考えております。

※お問い合わせ

〒050-8585 室蘭市水元町 27 番 1 号

室蘭工業大学 入試戦略課長 神川 理

TEL 0143-46-5160

FAX 0143-45-1381

試験科目名	応用物理学	受験番号	
【4】 物理系実験			

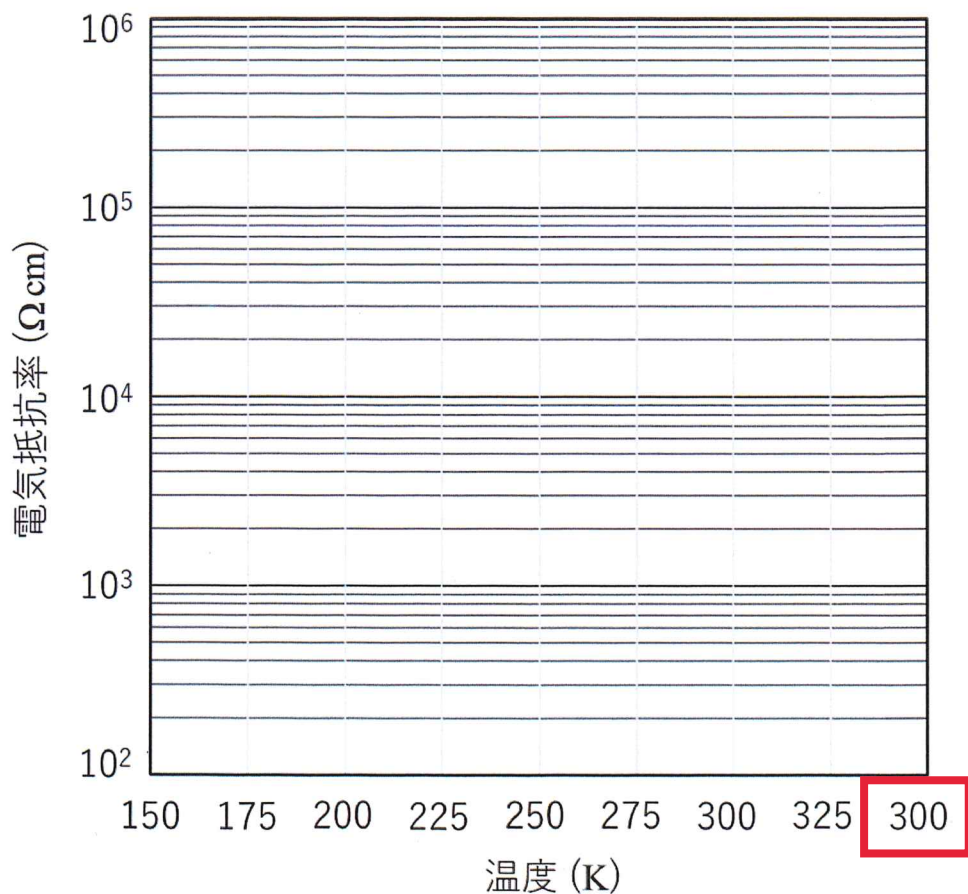
(3 ページ/4 ページ)

[4] 【20 点】

(1) 半導体の電気抵抗率の温度依存性を測定したところ、以下の表 1 のような結果が得られた。このデータをグラフにプロットしなさい。また、このグラフの特徴を簡単に説明しなさい。プロットの点は、黒丸ではっきりとわかりやすく記入すること。

表1

温度 (K)	電気抵抗率 ($\Omega \text{ cm}$)
300	1.00×10^3
275	4.20×10^3
250	1.80×10^4
225	1.20×10^5
200	1.00×10^6



グラフの特徴